

Silicon Diode

BAY36

30V / 100mA

DATASHEET

OEM – SEL

Source: SEL Databook 1965



Silizium-Planar-Dioden

BAY 31, 36**Ausführung:**

Silizium-Epitaxial-Planar-Dioden, Kathode durch roten Farbpunkt gekennzeichnet.

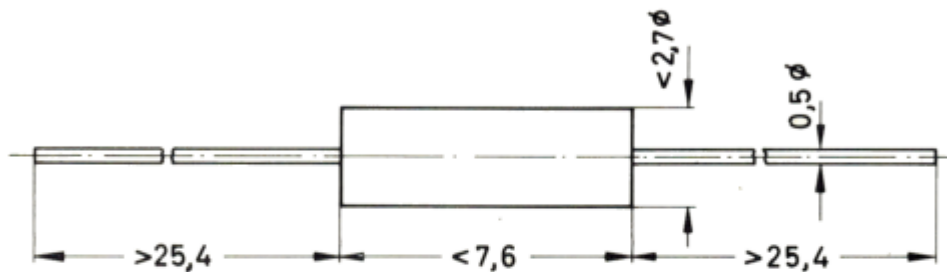
Verwendung:

Dioden für schnelle Schalter in der kommerziellen Technik.

Abmessungen:

(Maße in mm)

Gehäuse DO-7

**Grenzdaten**

			BAY 31	BAY 36	
Verlustleistung	$T_u = 25\text{ °C}$	P	200		mW
	$T_u = 45\text{ °C}$		170		mW
	$T_u = 100\text{ °C}$		100		mW
Sperrspannung	$T_u = 25\text{ °C}$	U_R	15	30	V
Durchlaßgleichstrom		I_F		100	mA
Durchlaßspitzenstrom		I_{FM}		200	mA
Maximale Lagertemperatur		$+T_s$	150		°C
Minimale Lagertemperatur		$-T_s$	55		°C
Maximale Sperrschichttemperatur		$+T_j$	135		°C
Minimale Sperrschichttemperatur		$-T_j$	55		°C

BAY 31, 36**Statische Kenndaten bei $T_u = 25\text{ °C}$**

			BAY 31	BAY 36	
Sperrstrom	$U_R = 10\text{ V}$	I_R	2,5 < 10 < 30		nA
		I_R^*	30 < 58 < 150		nA
		I_R^{**}	150 < 220 < 550		nA
		I_R^{***}	0,35 < 0,8 < 1,7		μA
	$U_R = 15\text{ V}$	I_R	3 < 20 < 220		nA
	$U_R = 20\text{ V}$	I_R		4 < 5 < 300	nA
	$U_R = 30\text{ V}$	I_R		6 < 11 < 2000	nA
Durchlaßstrom	$U_F = 1\text{ V}$	I_F	40 < 70 < 130		mA

* bei $T_j = 55\text{ °C}$ ** bei $T_j = 80\text{ °C}$ *** bei $T_j = 100\text{ °C}$ **Dynamische Kenndaten bei $T_u = 25\text{ °C}$**

			BAY 31	BAY 36	
Diodenkapazität	$U_R = 0,5\text{ V}$	C	3 < 6		pF
Sperrverzögerungszeit	von $I_F = 10\text{ mA}$ auf $U_R = 10\text{ V}$ bei $R_L = 100\ \Omega$	t_{rr}	2,1 < 3,5 < 4,5		ns

**BAY 31, 36**